



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0078406
(43) 공개일자 2014년06월25일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C09K 11/06 (2006.01) *H01L 51/50* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0147733
(22) 출원일자 2012년12월17일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘지디스플레이 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)
(72) 발명자
배숙영
서울 송파구 백제고분로12길 19-7, 302호 (잠실동)
(74) 대리인
특허법인로얄

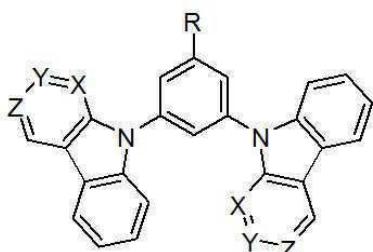
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 인광 화합물 및 이를 사용한 유기전계발광소자

(57) 요 약

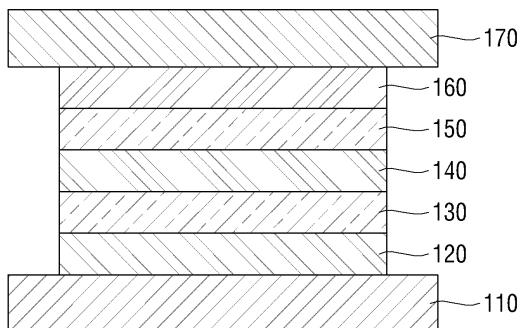
본 발명의 일 실시예에 따른 인광 화합물은 하기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 한다.

[화학식 1]



상기 화학식 1에서, 상기 X, Y 및 Z는 모두 탄소인 경우를 제외하고 각각 탄소 또는 질소 중 선택되고, 상기 치환된 R은 방향족 고리 화합물 또는 헤테로 고리 화합물이며 폐닐(phenyl), 디벤조티오펜(dibenzothiophene), 디벤조퓨란(dibenzofuran) 및 이들의 치환체로부터 선택된 어느 하나이다.

대 표 도 - 도1

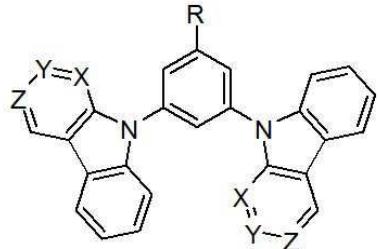


특허청구의 범위

청구항 1

하기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 하는 인광 화합물.

[화학식 1]



상기 화학식 1에서,

상기 X, Y 및 Z는 모두 탄소인 경우를 제외하고 각각 탄소 또는 질소 중 선택되고, 상기 치환된 R은 방향족 고리 화합물 또는 헤테로 고리 화합물이며 폐닐(phenyl), 디벤조티오펜(dibenzothiophene), 디벤조퓨란(dibenzofuran) 및 이들의 치환체로부터 선택된 어느 하나이다.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 X, Y 및 Z를 포함하는 카볼린기(carboline)는 X가 질소이고 Y와 Z가 탄소인 알파-카볼린기(α -carboline), Y가 질소이고 X와 Z가 탄소인 베타-카볼린기(β -carboline) 및 Z가 질소이고 X와 Y가 탄소인 감마-카볼린기(γ -carboline)로부터 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 인광 화합물.

청구항 3

제1 항에 있어서,

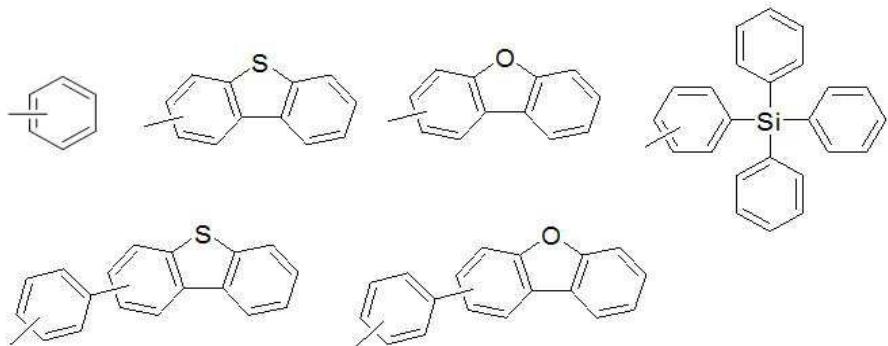
상기 방향족 고리 화합물의 치환체는 디벤조티오펜(dibenzothiophene), 디벤조퓨란(dibenzofuran) 및 실릴 화합물(Si compound)로부터 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 인광 화합물.

청구항 4

제1 항에 있어서,

상기 R은 하기 화학식 2로 표시되는 화합물들 중 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 인광 화합물.

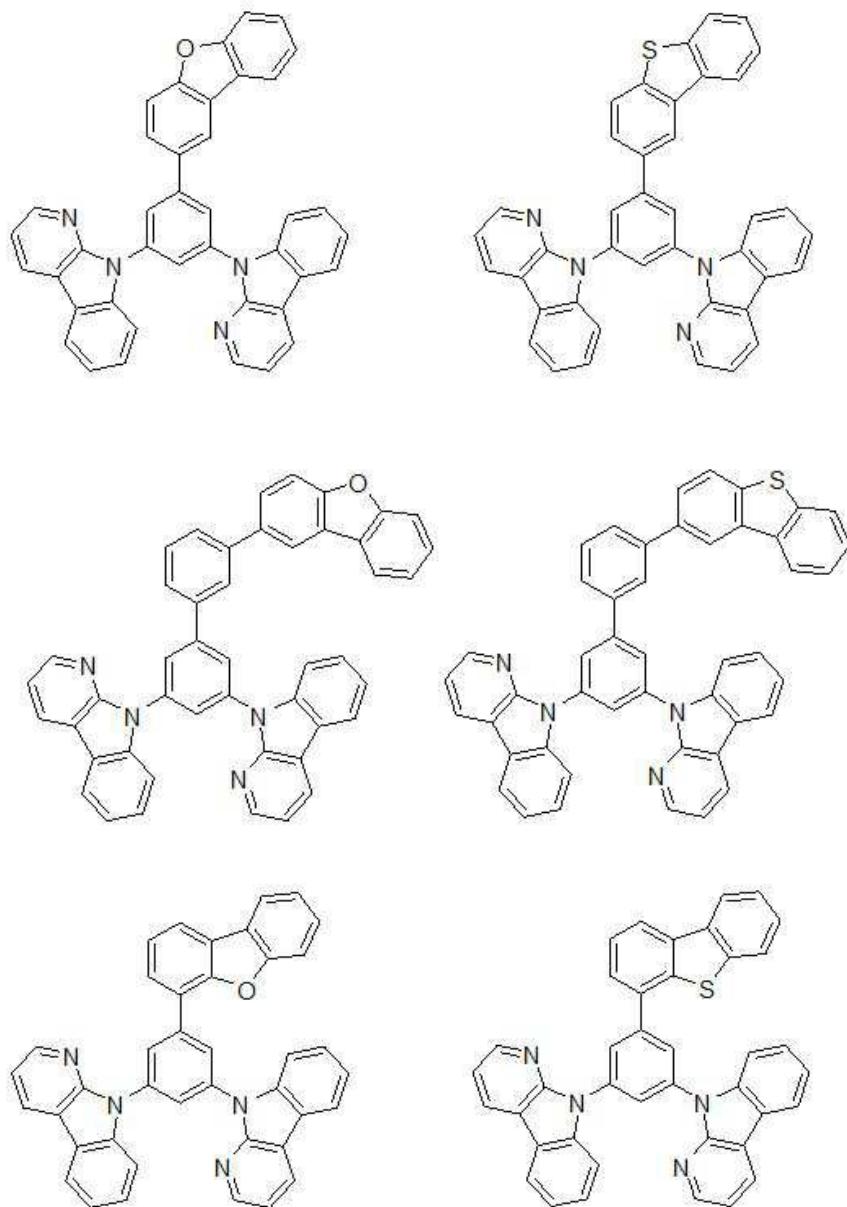
[화학식 2]

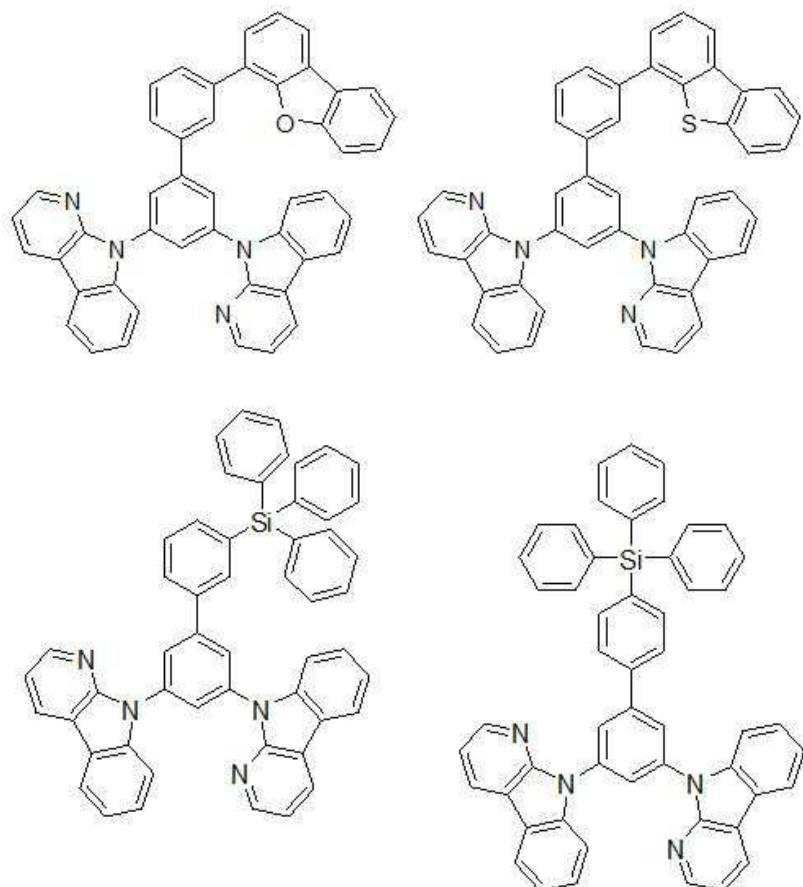


청구항 5

제1 항에 있어서,

상기 인광 화합물은 하기 표시되는 화합물들 중 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 인광 화합물.



**청구항 6**

양극과 음극 사이에 형성된 유기막을 포함하는 유기전계발광소자에 있어서,

상기 유기막이 상기 제1 항 내지 제5 항 중 어느 한 항의 인광 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 7

제6 항에 있어서,

상기 유기막이 발광층인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 8

제6 항에 있어서,

상기 화합물이 상기 발광층의 호스트로 사용되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 9

제6 항에 있어서,

상기 양극과 상기 음극 사이에 정공주입층, 정공수송층, 전자수송층 및 전자주입층 중 선택된 어느 하나 이상을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

명세서

기술분야

[0001]

본 발명은 인광 화합물 및 이를 사용한 유기전계발광소자에 관한 것으로, 보다 자세하게는, 삼중향 에너지가 높은 인광 화합물을 유기전계발광소자의 발광층의 호스트로 사용하는 유기전계발광소자에 관한 것이다.

배경기술

[0002]

최근, 표시장치(FPD: Flat Panel Display)는 멀티미디어의 발달과 함께 그 중요성이 증대되고 있다. 이에 부응하여 액정표시장치(Liquid Crystal Display : LCD), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel: PDP), 전계방출표시장치(Field Emission Display: FED), 유기전계발광소자(Organic Light Emitting Diode Device) 등과 같은 여러 가지의 디스플레이가 실용화되고 있다.

[0003]

이 중 유기전계발광소자는 플라스틱 같은 유연한 기판 위에도 소자를 형성할 수 있을 뿐 아니라, 플라즈마 디스플레이 패널이나 무기전계발광 디스플레이에 비해 10V 이하의 낮은 전압에서 구동이 가능하고, 전력소모가 비교적 적으며 색감이 뛰어나다는 장점이 있다. 또한, 유기전계발광소자는 적색, 녹색 및 청색의 3가지 색을 나타낼 수 있어 풍부한 색을 표현하는 차세대 디스플레이 소자로 많은 사람들의 관심의 대상이 되고 있다.

[0004]

유기전계발광소자는 양극, 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 및 음극을 순차적으로 적층하여 형성할 수 있다. 발광 재료의 경우 양쪽 전극에서부터 주입된 전자와 정공의 재결합에 의해 여기자가 형성되며, 일중향 여기자의 경우 형광, 삼중향 여기자의 경우 인광에 관여하게 된다. 최근에는 형광에서 인광으로 발광 재료가 변경되는 추세에 있다. 이는 형광의 경우 발광층에서 형성되는 엑시톤 중에 약 25%의 단일향만이 빛을 만드는데 사용되고 75%의 삼중향은 대부분 열로 소실되는 반면, 인광 재료는 이를 모두 빛으로 전환 시키는 발광 메카니즘을 가지고 있기 때문이다.

[0005]

인광 소자의 발광 프로세스를 간단히 살펴 보면, 양극으로부터 주입된 홀과 음극으로부터 주입된 전자가 발광층의 호스트 물질에서 만나게 된다. 물론 도편트에서 바로 홀과 전자쌍이 만나는 경우도 있지만 일반적으로 호스트의 농도가 높기 때문에 많은 양이 호스트에서 만나게 된다. 이때, 호스트에서 형성된 단일향 엑시톤은 도편트의 단일향 또는 삼중향으로 에너지 전이가 일어나며, 삼중향 엑시톤은 도편트의 삼중향으로 에너지 전이가 일어나게 된다.

[0006]

일단, 도편트의 단일향으로 전이된 엑시톤은 다시 Inter system crossing을 통하여 도편트의 삼중향으로 전이됨으로 모든 엑시톤의 1차 종착지는 도편트의 삼중향 준위이다. 이렇게 형성된 엑시톤은 그라운드 상태(ground state)로 전이되며 빛을 발생한다. 이때 발광층 앞과 뒤에 인접한 정공 수송층 또는 전자 수송층의 삼중향 에너지가 도편트의 삼중향 에너지보다 작을 경우는 도편트 또는 호스트에서 이를 충으로 역 에너지 전이가 발생하여 효율을 급격히 떨어뜨린다. 따라서 발광층의 호스트 재료 뿐만 아니라 정공/전자 이동층의 삼중향 에너지도 인광 소자에 있어 매우 중요한 역할을 한다.

[0007]

호스트에서 도편트로 효율적인 에너지 전이를 위해 호스트의 삼중향 에너지는 도편트의 삼중향 에너지보다 반드시 커야만 한다. 하지만 최근 널리 사용되는 CBP의 경우 삼중향 에너지가 2.6 eV 이므로 잘 알려진 Firpic 인광 도편트를 사용하였을 경우, 호스트에서 도편트로 역 에너지(흡열) 전이현상이 발생하여 효율이 감소한다. 따라서, 삼중향 에너지가 높으면서 열 안정성이 우수한 신규 인광 물질의 개발이 절실히 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

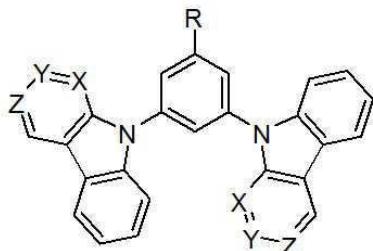
[0008]

따라서, 본 발명은 유기전계발광소자의 발광층에 신규한 인광 화합물을 발광층의 호스트로서 사용하여, 고효율의 유기전계발광소자를 제공하는데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 인광 화합물은 하기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 한다.

[0010] [화학식 1]



[0011]

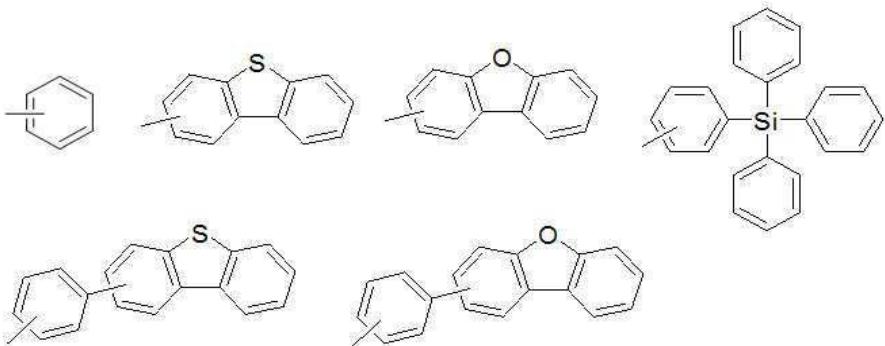
[0012] 상기 화학식 1에서, 상기 X, Y 및 Z는 모두 탄소인 경우를 제외하고 각각 탄소 또는 질소 중 선택되고, 상기 치환된 R은 방향족 고리 화합물 또는 헤테로 고리 화합물이며 페닐(phenyl), 디벤조티오펜(dibenzothiophene), 디벤조퓨란(dibenzofuran) 및 이들의 치환체로부터 선택된 어느 하나이다.

[0013] 상기 X, Y 및 Z를 포함하는 카볼린기(carboline)는 X가 질소이고 Y와 Z가 탄소인 알파-카볼린기(α -carboline), Y가 질소이고 X와 Z가 탄소인 베타-카볼린기(β -carboline) 및 Z가 질소이고 X와 Y가 탄소인 감마-카볼린기(γ -carboline)로부터 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 한다.

[0014] 상기 방향족 고리 화합물의 치환체는 디벤조티오펜(dibenzothiophene), 디벤조퓨란(dibenzofuran) 및 실릴 화합물(Si compound)로부터 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 한다.

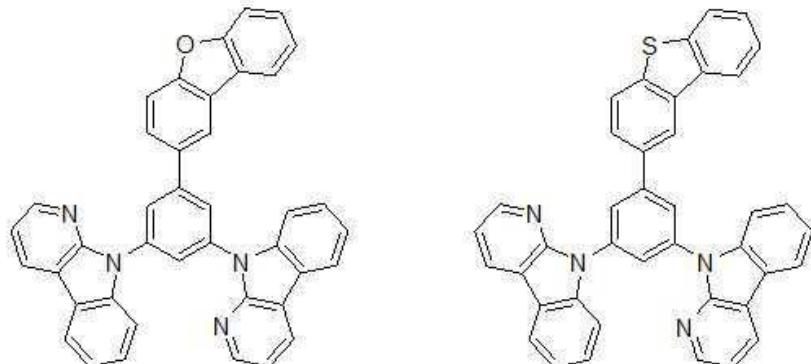
[0015] 상기 R은 하기 화학식 2로 표시되는 화합물을 중 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 한다.

[0016] [화학식 2]

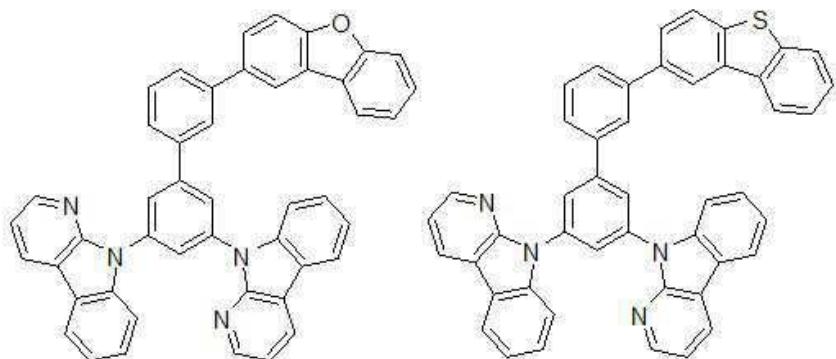


[0017]

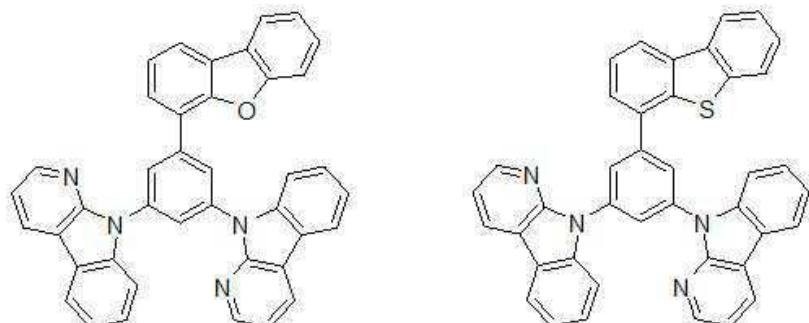
[0018] 상기 인광 화합물은 하기 표시되는 화합물들 중 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 한다.



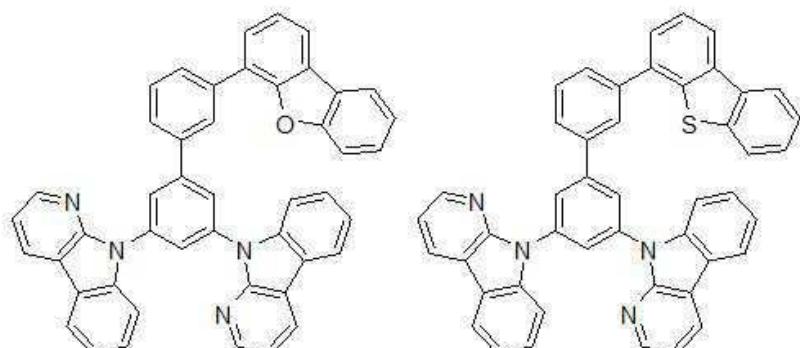
[0019]



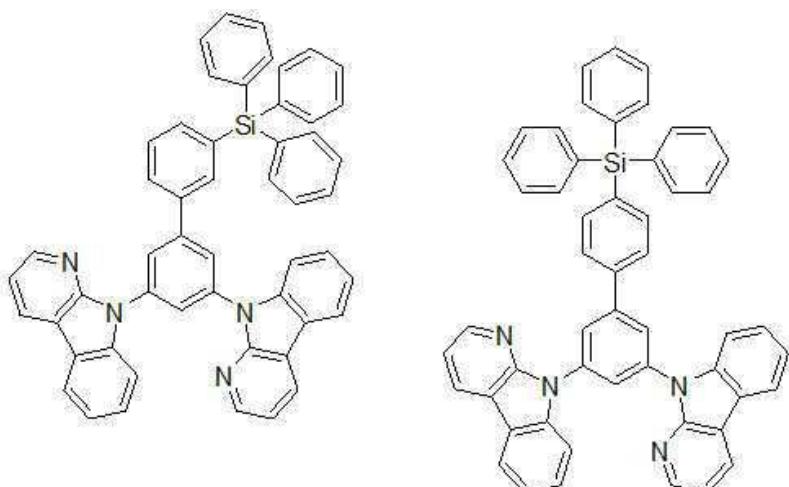
[0020]



[0021]



[0022]



[0023]

[0024] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광소자는 양극과 음극 사이에 형성된 유기막을 포함하는 유기전계발광소자에 있어서, 상기 유기막이 상기 인광 화합물을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0025] 상기 유기막이 발광층인 것을 특징으로 한다.

- [0026] 상기 화합물이 상기 발광층의 호스트로 사용되는 것을 특징으로 한다.
- [0027] 상기 양극과 상기 음극 사이에 정공주입층, 정공수송층, 전자수송층 및 전자주입층 중 선택된 어느 하나 이상을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

- [0028] 본 발명의 일 실시예에 따른 인광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자는 삼중향 에너지가 높은 신규한 인광 화합물을 제조하고, 이를 유기전계발광소자의 발광층의 호스트로 형성함으로써, 발광층에서의 에너지 전이를 용이하게 하여 발광효율을 향상시킬 수 있는 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

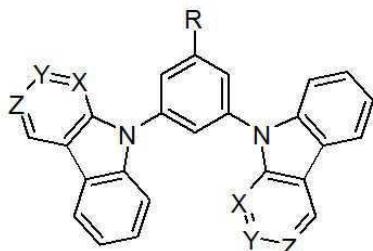
- [0029] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광소자를 나타낸 도면.
 도 2는 본 발명의 제1 및 제2 호스트의 UV 흡수 스펙트럼을 측정한 그래프.
 도 3은 본 발명의 제1 및 제2 호스트의 저온(77K)에서의 PL 스펙트럼을 측정한 그래프.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시 예들을 자세하게 설명하면 다음과 같다.
- [0031] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광소자를 나타낸 도면이다.
- [0032] 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광소자(100)는 양극(110), 정공주입층(120), 정공수송층(130), 발광층(140), 전자수송층(150), 전자주입층(160) 및 음극(170)을 포함할 수 있다.
- [0033] 상기 양극(110)은 정공을 주입하는 전극으로 일함수가 높은 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide) 또는 ZnO(Zinc Oxide) 중 어느 하나일 수 있다. 또한, 상기 양극(110)이 반사 전극일 경우에 양극(110)은 ITO, IZO 또는 ZnO 중 어느 하나로 이루어진 층 하부에 알루미늄(Al), 은(Ag) 또는 니켈(Ni) 중 어느 하나로 이루어진 반사층을 더 포함할 수 있다.
- [0034] 상기 정공주입층(120)은 양극(110)으로부터 발광층(140)으로 정공의 주입을 원활하게 하는 역할을 할 수 있으며, CuPc(cupper phthalocyanine), PEDOT(poly(3,4)-ethylenedioxythiophene), PANI(polyaniline) 및 NPD(N,N-dinaphthyl-N,N'-diphenyl benzidine)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0035] 상기 정공주입층(120)의 두께는 1 내지 150nm일 수 있다. 여기서, 상기 정공주입층(120)의 두께가 1nm 이상이면, 정공 주입 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있고, 150nm 이하이면, 정공주입층(120)의 두께가 너무 두꺼워 정공의 이동을 향상시키기 위해 구동전압이 상승되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있다.
- [0036] 상기 정공수송층(130)은 정공의 수송을 원활하게 하는 역할을 하며, NPD(N,N-dinaphthyl-N,N'-diphenyl benzidine), TPD(N,N'-bis-(3-methylphenyl)-N,N'-bis-(phenyl)-benzidine), s-TAD 및 MTDATA(4,4',4''-Tris(N-3-methylphenyl-N-phenyl-amino)-triphenylamine)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
- [0037] 상기 정공수송층(130)의 두께는 1 내지 150nm일 수 있다. 여기서, 상기 정공수송층(130)의 두께가 5nm 이상이면, 정공 수송 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있고, 150nm 이하이면, 정공수송층(130)의 두께가 너무 두꺼워 정공의 이동을 향상시키기 위해 구동전압이 상승되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있다.
- [0038] 상기 발광층(140)은 적색, 녹색 및 청색을 발광하는 물질로 이루어질 수 있으며, 인광 또는 형광물질을 이용하여 형성할 수 있다. 본 실시 예에서는 녹색 및 청색을 발광하는 발광층의 인광 화합물에 대해 설명한다.
- [0039] 본 발명의 발광층(140)은 호스트(host)와 도핀트(dopant)로 이루어진다. 보다 자세하게, 본 발명의 호스트는 하

기 화학식 1로 표시되는 인광 화합물로 이루어진다.

[0040] [화학식 1]



[0041]

상기 화학식 1에서, X, Y 및 Z는 모두 탄소인 경우를 제외하고 각각 탄소 또는 질소 중 선택되고, 상기 치환된 R은 방향족 고리 화합물 또는 헤테로 고리 화합물이며 페닐(phenyl), 디벤조티오펜(dibenzothiophene), 디벤조퓨란(dibenzofuran) 및 이들의 치환체로부터 선택된 어느 하나이다.

[0043]

상기 X, Y 및 Z를 포함하는 카볼린기(carboline)는 X가 질소이고 Y와 Z가 탄소인 알파-카볼린기(α -carboline), Y가 질소이고 X와 Z가 탄소인 베타-카볼린기(β -carboline) 및 Z가 질소이고 X와 Y가 탄소인 감마-카볼린기(γ -carboline)로부터 선택된 어느 하나일 수 있다.

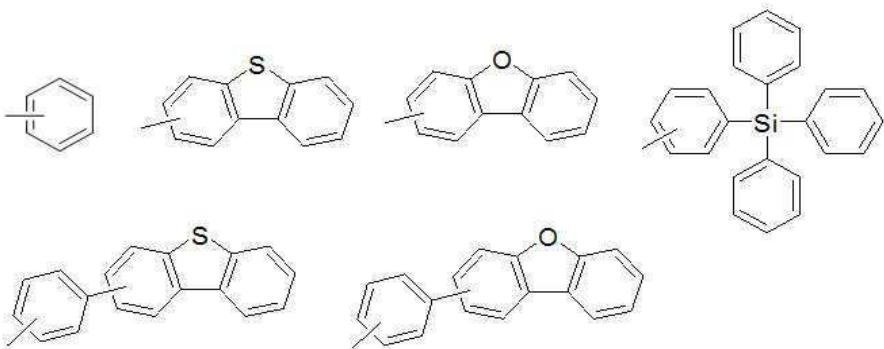
[0044]

상기 방향족 고리 화합물의 치환체는 디벤조티오펜(dibenzothiophene), 디벤조퓨란(dibenzofuran) 및 실릴 화합물(Si compound)로부터 선택된 어느 하나일 수 있다.

[0045]

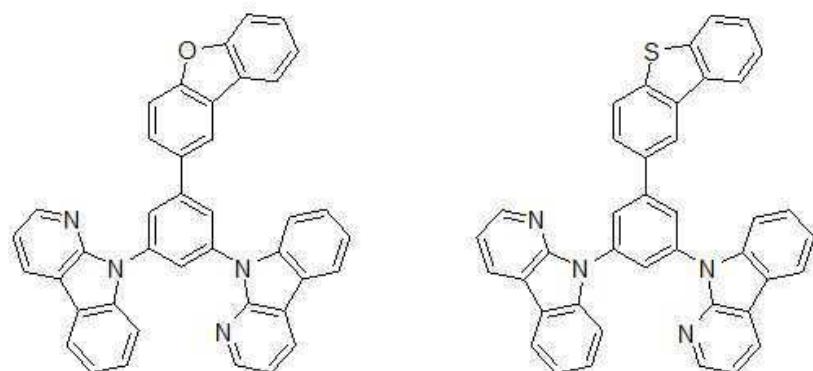
상기 R은 하기 화학식 2로 표시되는 화합물들 중 선택된 어느 하나일 수 있다.

[0046] [화학식 2]

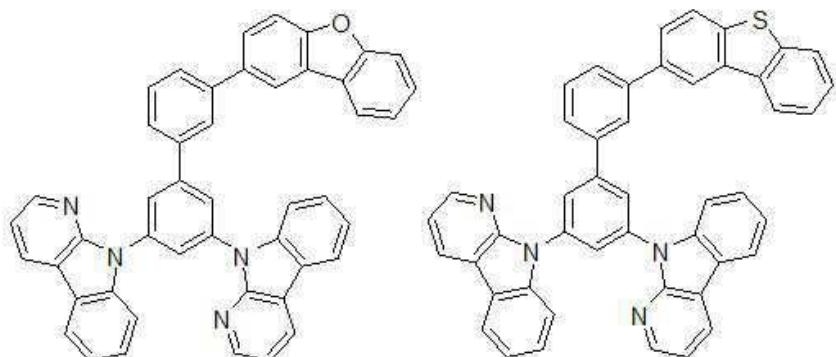


[0047]

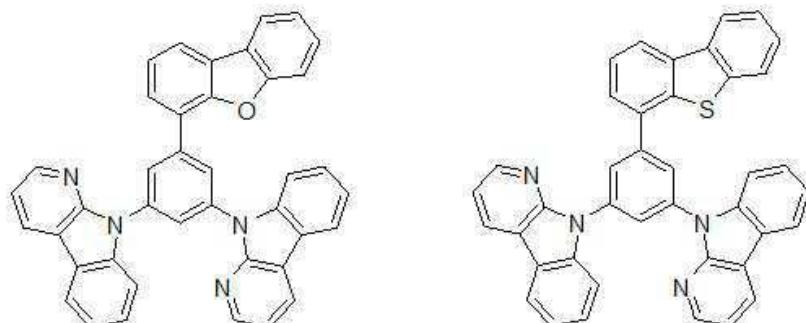
상기 인광 화합물은 하기 표시되는 화합물들 중 선택된 어느 하나일 수 있다.



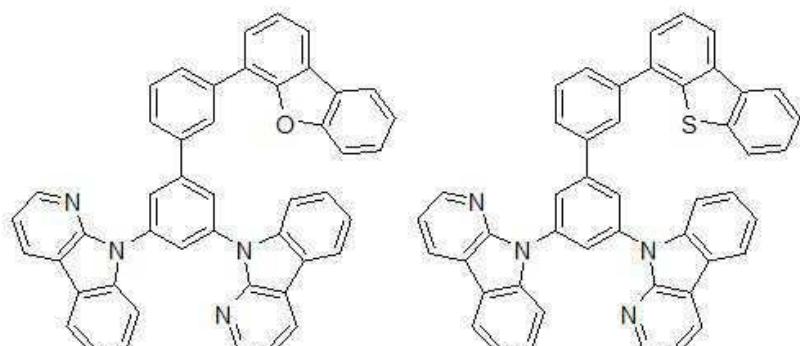
[0049]



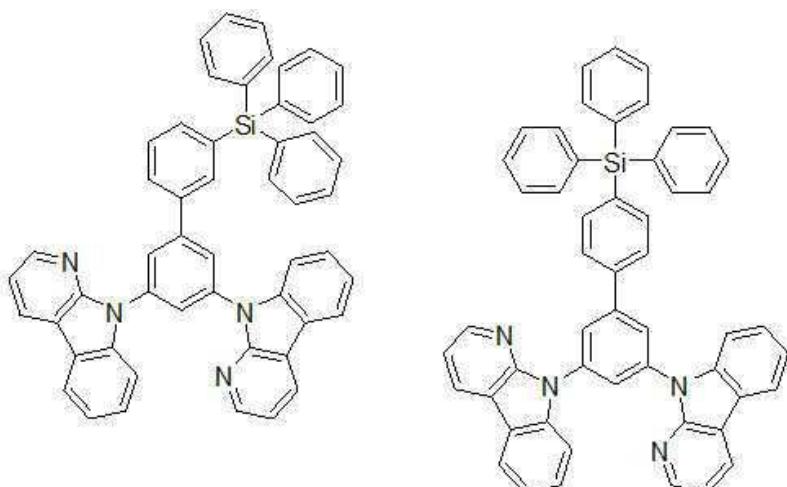
[0050]



[0051]



[0052]



[0053]

[0054] 본 발명의 화합물은 코어(core)에 전자의 성격이 강한 카볼린(carboline)을 도입하여 높은 삼중향 에너지를 가지고, 별 모양(star-shaped)으로 설계되어 유리전이온도(Tg)가 상승된다.

[0055]

한편, 전자수송층(150)은 전자의 수송을 원활하게 하는 역할을 하며, Alq₃(tris(8-hydroxyquinolino)aluminum), PBD, TAZ, spiro-PBD, BA1q 및 SA1q로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으

로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0056] 상기 전자수송층(150)의 두께는 1 내지 50nm일 수 있다. 여기서, 상기 전자수송층(150)의 두께가 1nm 이상이면, 전자 수송 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있고, 50nm 이하이면, 전자수송층(150)의 두께가 너무 두꺼워 전자의 이동을 향상시키기 위해 구동전압이 상승되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있다.

[0057] 상기 전자주입층(160)은 전자의 주입을 원활하게 하는 역할을 하며, Alq3(tris(8-hydroxyquinolino)aluminum), PBD, TAZ, spiro-PBD, BA1q 또는 SA1q를 사용할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

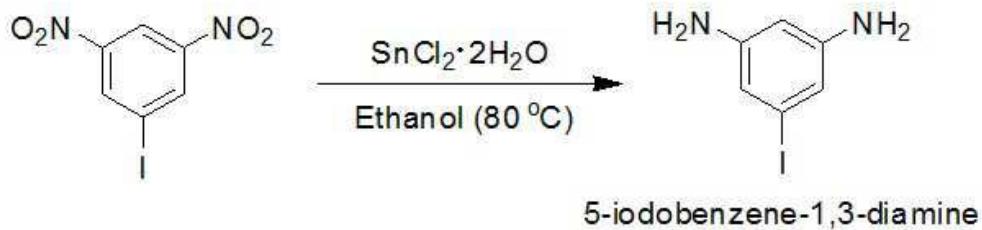
[0058] 상기 전자주입층(160)의 두께는 1 내지 50nm일 수 있다. 여기서, 상기 전자주입층(160)의 두께가 1nm 이상이면, 전자 주입 특성이 저하되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있고, 50nm 이하이면, 전자주입층(160)의 두께가 너무 두꺼워 전자의 이동을 향상시키기 위해 구동전압이 상승되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있다.

[0059] 상기 음극(170)은 전자 주입 전극으로, 일함수가 낮은 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 알루미늄(Al), 은(Ag) 또는 이들의 합금으로 이루어질 수 있다. 여기서, 양극(170)은 유기전계발광소자가 전면 또는 양면발광구조일 경우, 빛을 투과할 수 있을 정도로 얇은 두께로 형성할 수 있으며, 유기전계발광소자가 배면발광구조일 경우, 빛을 반사시킬 수 있을 정도로 두껍게 형성할 수 있다.

[0060] 이하, 본 발명의 인광 화합물의 실시예 및 이 화합물의 특성에 관하여 하기 실시예에서 상술하기로 한다. 다만, 하기의 실시예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐 본 발명이 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다.

실시예

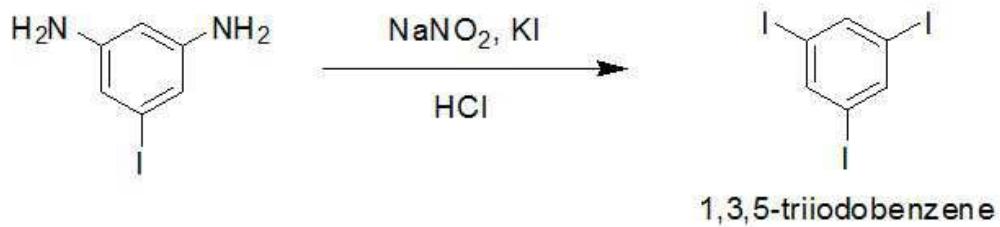
[0061] 1) 5-아이도벤젠-1,3-디아민(5-iodobenzene-1,3-diamine)의 제조



[0063]

[0064] 500mL 2구 플라스크에 1-아이도-3,5-디니트로벤젠(1-iodo-3,5-dinitrobenzene)(7g, 0.024mol)을 에탄올(ethanol)에 넣은 후 $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 를 넣는다. 80°C에서 6시간 환류 교반시킨다. 반응 종료 후 40wt% 수산화나트륨(NaOH)를 적가한다. 톨루엔(Toluene)으로 추출한 후 헥산(hexane)으로 재결정하여 고체 3.1g(55.3%)를 얻었다.

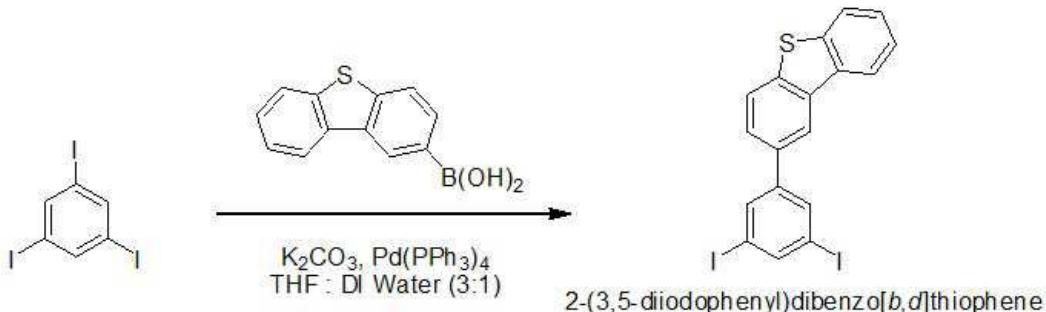
[0065] 2) 1,3,5-트리아이도벤젠(1,3,5-triiodobenzene)의 제조



[0066]

[0067] 250mL 2구 플라스크에 5-아이도벤젠-1,3-디아민(5-iodobenzene-1,3-diamine)(3.1g, 0.0133mol)을 염산(HCl)에 녹인다. 얼음물로 0°C로 만든 후 질산나트륨(NaNO₂)을 초순수(DI water)에 녹여서 적가 한다. 상온으로 온도를 올린 후 요오드화칼륨(KI)을 초순수에 녹인 후 적가 한다. 황산나트륨(Na₂SO₃)을 넣은 후 생성된 고체를 필터하고 컬럼 분리하여 흰색 고체 2.93g(48.5%)를 얻는다.

[0068] 3) 2-(3,5-디아이오도페닐)디벤조[b,d]티오펜(2-(3,5-di iodophenyl)dibenzo[b,d]thiophene)의 제조

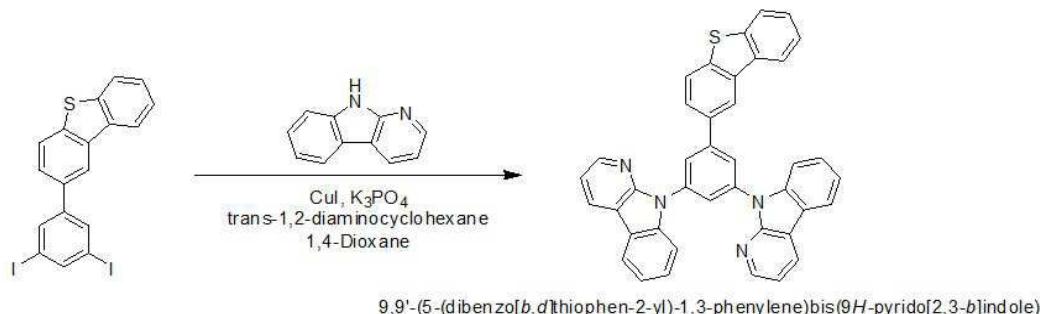


[0069]

[0070] 250mL 2구 플라스크에 1,3,5-트리아이오도벤젠(1,3,5-tri iodobenzene)(12.0g, 26.4mmol), 디벤조[b,d]티오펜-4-보로닉산(dibenzo[b,d]thiophen-4-ylboronic acid)(3.0g, 13.2mmol), 탄산칼륨(K₂CO₃)(5.45g, 39.5mmol), 팔라듐촉매 (Pd(PPh₃)₄)(0.018g, 3.95mmol)를 넣고 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran, THF) 90mL, 초순수 30mL로 녹인다. 그리고 환류 교반시킨다. 반응종료 후 용매를 감압증류하고 메틸렌 클로라이드:헥산(methylene chloride:hexane)(1:4)을 이용하여 컬럼(column)을 한다. 그리고 나서 석유 에테르(petroleum ether)로 침전하여 흰색 고체 2.81g(41.6%)를 얻었다.

[0071]

4) 제1 호스트 9,9'-(5-(디벤조[b,d]티오펜-2-일)-1,3-페닐렌)비스(9H-파리도[2,3,-b]인돌)(9,9'-(5-(dibenzo[b,d]thiophen-2-yl)-1,3-phenylene)bis(9H-pyrido[2,3-b]indole))의 제조

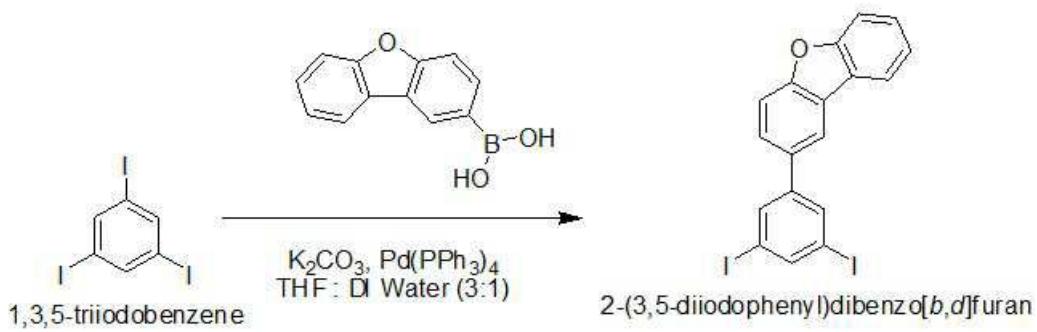


[0072]

[0073] 250mL 2구 플라스크에 2-(3,5-디아이오도페닐)디벤조[b,d]티오펜(2-(3,5-di iodophenyl)dibenzo[b,d]thiophene)(1.50g, 2.92mmol), 알파-카볼린(α -carboline)(0.98g, 5.85mmol), 요오드화구리(CuI)(0.167g, 0.877mmol), 인산칼륨(K₃PO₄)(1.24g, 5.85mmol), 트랜스-1,2-디아미노시클로헥산(trans-1,2-diaminocyclohexane)(0.101g, 0.88mmol)을 넣고 1,4-디옥산(1,4-dioxane) 100mL로 녹인다. 그리고 나서 24시간 동안 환류 교반시킨다. 반응종료 후 용매를 감압증류하고 디클로로메탄(CH₂Cl₂)을 이용하여 솟 컬럼(short column)을 한다. 디클로로메탄으로 재결정하여 흰색 고체 0.87g(50.0%)를 얻었다.

[0074]

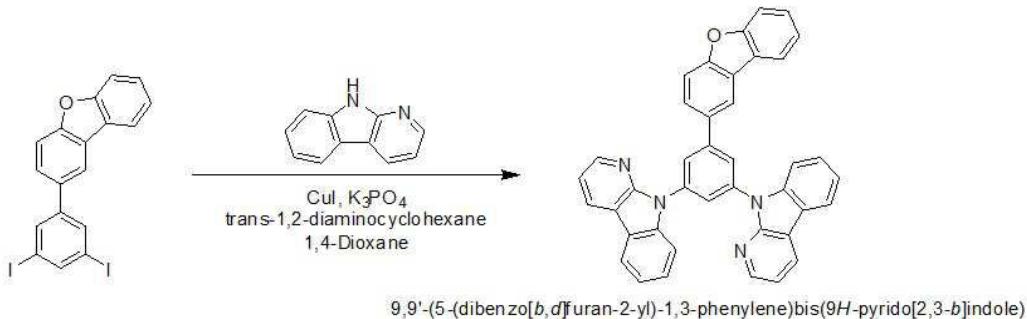
5) 2-(3,5-디아이오도페닐)디벤조[b,d]퓨란(2-(3,5-di iodophenyl)dibenzo[b,d]furan)의 제조



[0075]

[0076] 500mL 2구 플라스크에 1,3,5-트리아이오도벤젠(1,3,5-triiodobenzene)(10.0g, 21.9mmol), 디벤조[b,d]퓨란-2-일-보로닉산(dibenzo[b,d]furan-2-yl-boronic acid)(2.3g, 11.0mmol), 탄산칼륨(K_2CO_3)(4.56g, 33.0mmol), 팔라듐촉매($Pd(PPh_3)_4$)(3.81g, 3.30mmol)를 넣고 테트라하이드로퓨란(THF) 150 mL, 초순수 50mL로 녹인다. 그리고 환류 교반시킨다. 반응종료 후 용매를 감압증류 하고 메틸렌 클로라이드:헥산(methylene chloride : hexane)(1:4)를 이용하여 컬럼한다. 그리고 나서 석유 에테르로 침전시켜 흰색 고체 5.46g(45.0%)를 얻었다.

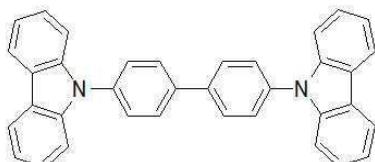
[0077] 6) 제2 호스트 9,9'-(5-(디벤조[b,d]퓨란-2-일)-1,3-페닐렌)비스(9H-피리도[2,3-b]인돌)(9,9'-(5-(dibenzo[b,d]furan-2-yl)-1,3-phenylene)bis(9H-pyrido[2,3-b]indole))의 제조



[0078]

[0079] 250mL 2구 플라스크에 2-(3,5-디아이오도페닐)디벤조[b,d]퓨란(2-(3,5-diiodophenyl)dibenzo[b,d]furan)(1.50g, 3.02mmol), 알파-카볼린(α -carboline)(1.02g, 6.05mmol), 요오드화구리(CuI)(0.173g, 0.906mmol), 인산칼륨(K_3PO_4)(1.28g, 6.04mmol), 트랜스-1,2-디아미노시클로헥산(trans-1,2-diaminocyclohexane)(0.104g, 0.906mmol)를 넣고 1,4-디옥산(1,4-dioxane) 100mL로 녹인다. 그리고나서 24시간 동안 환류 교반시킨다. 반응종료 후 용매를 감압증류하고 디클로로메탄을 이용하여 솟 컬럼한다. 디클로로메탄으로 재결정을 하여 흰색 고체 0.96g(55.0%)를 얻었다.

[0080] 전술한 실시예에서 제조된 본 발명의 제1 및 제2 호스트의 UV 흡수 스펙트럼과 저온(77K)에서의 PL 스펙트럼을 측정하여 도 2 및 도 3에 나타내었고 이를 비교예로 CBP 물질과 비교하여 표 1에 정리하였다.



[0081]

CBP

표 1

	UV 흡수 스펙트럼의 최고값에서의 파장(nm)	PL 스펙트럼의 최고값에서의 파장(nm)	에너지 밴드갭	LUMO (eV)	레벨	HOMO (eV)	레벨	삼중향지(eV)
비교예	359	478	3.46	-2.5	-6.0	2.60		
제1호스트	347	450	3.58	-2.26	-5.84	2.76		
제2호스트	347	437	3.58	-2.28	-5.86	2.84		

[0083] 상기 표 1, 도 2 및 3을 참고하면, 본 발명의 일 실시예에 따라 제조된 제1 및 제2 호스트 물질의 삼중향 에너지가 비교예의 2.60보다 높게 나타나는 것을 확인하였다.

[0084] 본 발명의 일 실시예에 따른 인광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자는 삼중향 에너지가 높은 신규한

인광 화합물을 제조하고, 이를 유기전계발광소자의 발광층의 호스트로 형성함으로써, 발광층에서의 에너지 전이를 용이하게 하여 발광효율을 향상시킬 수 있는 이점이 있다.

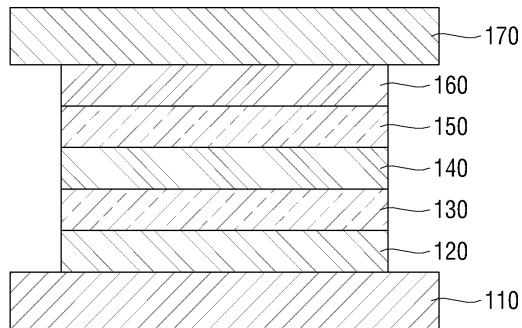
[0085] 이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 한다. 아울러, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어진다. 또한, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

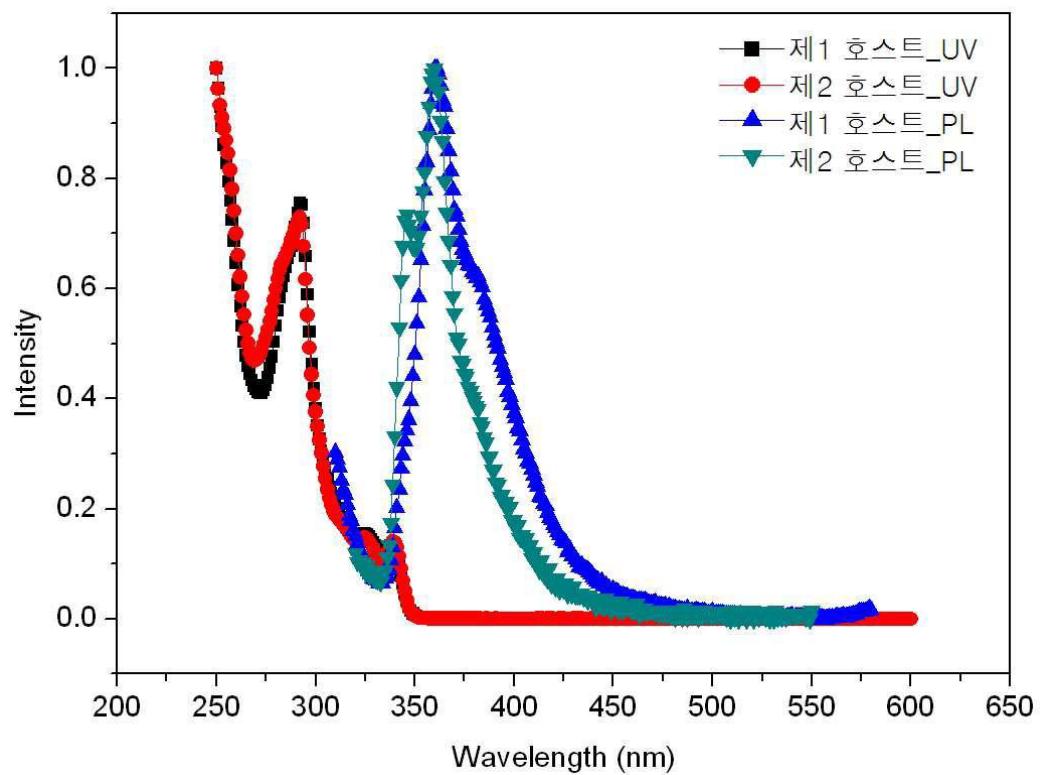
[0086]	100 : 유기전계발광소자	110 : 양극
	120 : 정공주입층	130 : 정공수송층
	140 : 발광층	150 : 전자수송층
	160 : 전자주입층	170 : 음극

도면

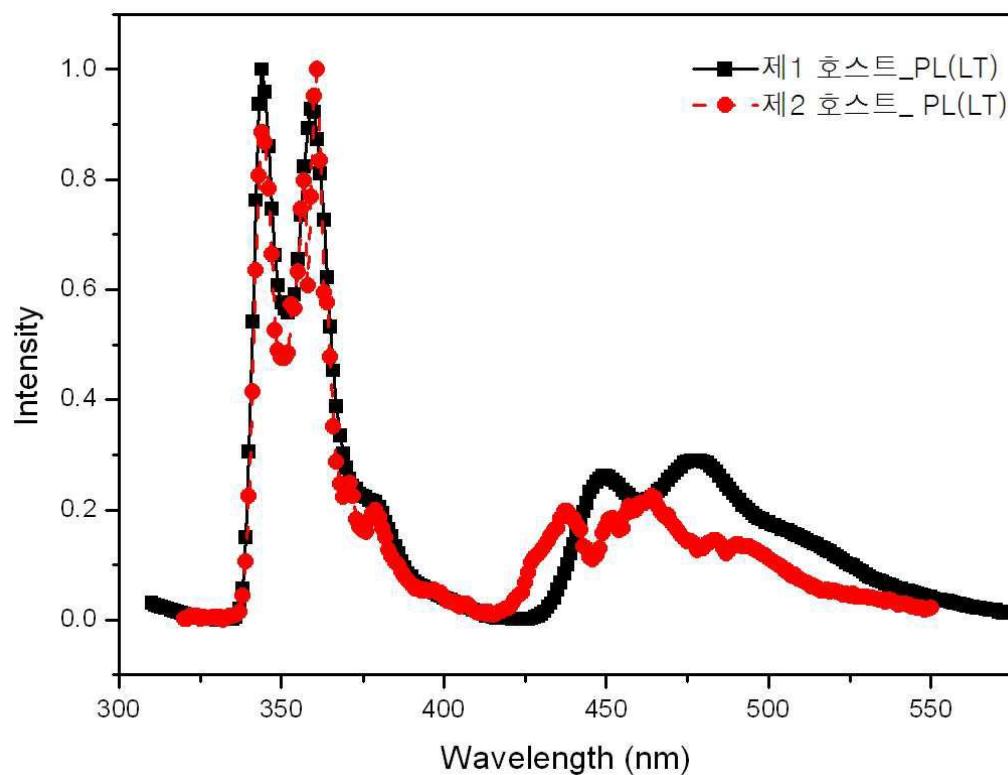
도면1



도면2



도면3



专利名称(译)	标题 : 磷光体化合物和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	KR1020140078406A	公开(公告)日	2014-06-25
申请号	KR1020120147733	申请日	2012-12-17
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	BAE SUK YOUNG 배숙영		
发明人	배숙영		
IPC分类号	C09K11/06 H01L51/50		
CPC分类号	H01L51/0072 C07D333/72 C07D487/00 H01L51/0071 H01L51/0073 H01L51/0074		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

根据本发明一个实施方案的磷光化合物由化学式1表示。在化学式1中，X，Y和Z分别选自碳和氮，除了它们全部是碳，取代的R是芳环化合物或杂环化合物是选自苯基，二苯并噻吩，二苯并呋喃及其取代基中的一种。

